# 电子元件手册 Electronic Components Manual

#### 丁毅

(中国科学院大学, 北京 100049)

### Yi Ding

(University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

2024.11 - ...

## 序言

本文为笔者本科时的电子元件手册,对学习过程中接触较多的元件作了系统性的介绍和总结,同时对部分元件进行了仿真或实际电路测试,给出了相应的参数曲线或波形图。

随着学习的不断深入,笔者对某些元件的认识一定会更加深刻,也会认识新的元件。因此,笔者打算将本手册作为一份长期更新的(真的很长期)电子元件手册,既是我个人对元件知识的总结,也是便于以后自己参考。读者可到我的 GitHub 下载手册的最新版本 https://github.com/YiDingg/LatexNotes,也可以在我的个人网站 待更新 上找到相关资料,包括各元件的 Data Sheet、学习电子元件及其相关电路的优秀网站等(例如 Electornics Tutorials)。

另外,有相当一部分元件(例如 Operational Amplifier)其实是基础元件所构成的模块化电路。在本书,我们不会详谈如何通过基本元件搭建出这些进阶元件,而是讨论如何对这些元件(模块化的电路)建立正确的认识,探究在不同情况下应该选用怎样的模型进行分析,以达到足够高的精度,同时尽可能地降低模型复杂度。实现它们的具体电路,以及 Oscillators、Amplifiers 和 Power Supplies 等模块化电路,会放到另一本书"电子电路手册"中,读者可到网址 待更新 自行下载和阅读。为了提高读者的自学效率,笔者在这里推荐几个免费且优秀的电子学习网站:

- (1) Electornics Tutorials: 这个网站提供了丰富的电子学习资料,包括 Transistors、Amplifiers、Diodes、Filters等,还提供了很多实用的电子工程师工具,例如在线电阻电感电容计算器等;
- (2) <a href="https://www.learnabout-electronics.org/">https://www.learnabout-electronics.org/</a>: 这个网站提供了电子学习的基础和进阶知识,包括 Semiconductors, Amplifiers, Oscillators, Power Supplies 等,最令人惊喜的是几乎所有资料都提供了 PDF 下载,方便读者下载后自行学习;
- (3) https://www.electronics-lab.com: 这个网站不仅开源了很多电子电路设计实例,包括基础电路、模拟电路、数字电路等,还提供了丰富的学习资源(文章)在 here;
- (4) <a href="https://developerhelp.microchip.com/">https://developerhelp.microchip.com/</a>: 这是 Microchip 官方的开发者帮助网站,提供了大量的电子元件的 Data Sheet、Application Notes、Reference Manuals 等,是学习 Microchip 产品的重要参考网站,当然,在这里也可以找到与模拟电路、数字电路相关的的学习资料;

由于个人学识浅陋,认识有限,文中难免有不妥甚至错误之处,望读者不吝指正。读者可以将错误发送到我的邮箱 dingyi233@mails.ucas.ac.cn,也可以到笔者的 GitHub (https://github.com/YiDingg/LatexNotes) 上提 issue,衷心感谢。

# 景目

| 目录 |                   | I  |    |
|----|-------------------|--|----|
|    |                   | II   |    |
| 1  | Resi              | istors (电阻)  | 1  |
| 2  | Cap               | acitors (电容)   | 2  |
| 3  | Indu              | uctors (电感)  | 3  |
| 4  | Diodes (二极管)      |  | 4  |
|    | 4.1               | Power/Rectifier/General Diode (功率/整流/通用二极管)                                  | 4  |
|    |                   | 4.1.1 1N4007 [GOODWORK (固得沃克)]   | 4  |
|    | 4.2               | Voltage regulator diode (稳压二极管)  | 5  |
|    | 4.3               | LED (Light Emitting Diode) (发光二极管)   | 5  |
|    |                   | 4.3.1 XL-302 [XINGLIGHT (成兴光)]   | 5  |
|    |                   | 4.3.2 LED [某宝]   | 5  |
|    | 4.4               | Schottky Diode (肖特基二极管)  | 6  |
| 5  | Transistors (晶体管) |  | 7  |
|    | 5.1               | BTJ (Bipolar Transistor Junction) (双极型晶体管)                                   | 7  |
|    | 5.2               | JFET (Junction Field Effect Transistor) (结型场效应晶体管)                           | 7  |
|    | 5.3               | MOSFET (Metal-Oxide -Semiconductor Field Effect Transistor) (金属氧化物半导体场效应晶体管) | 7  |
|    |                   | 5.3.1 2N7000 [onsemi (安森美)]  | 7  |
|    | 5.4               | MODFET (Modulation Doped Field Effect Transistor) (调制掺杂场效应晶体管)               | 10 |
|    | 5.5               | Darlington Transistors (达林顿晶体管)  | 10 |
| 6  | Amj               | plifiers   | 11 |
|    | 6.1               | Common Emitter Amplifier (共射极放大器)  | 11 |
|    | 6.2               | Common Base Amplifier (共基极放大器)   | 11 |
|    | 6.3               | Common Collector Amplifier (共集极放大器)  | 11 |
|    | 6.4               | Common Source Amplifier (共源极放大器)   | 11 |
|    | 6.5               | MOSFET Amplifier (MOSFET 放大器)  | 11 |
|    |                   | 6.5.1 LM258P   | 11 |
|    |                   | 6.5.2 NE5532P  | 11 |
|    |                   | 6.5.3 LM318N   | 11 |
|    | 6.6               | Class AB Amplifier (AB 类放大器)   | 11 |
| 7  |                   |  | 12 |

# 第1章 Resistors (电阻)

# 第2章 Capacitors (电容)

# 第3章 Inductors (电感)

## 第4章 Diodes (二极管)

二极管分为...

## §4.1 Power/Rectifier/General Diode (功率/整流/通用二极管)

#### 4.1.1 1N4007 [GOODWORK (固得沃克)]

由 GOODWORK (固得沃克, 中国江苏) 生产的 1N4007 是一种功率/整流/通用二极管, 常应用于整流电路等(同类型的有 1N4000, 1N4001, ..., 1N4006), 可以在立创商城或 GOODWORK 官网上找到它。

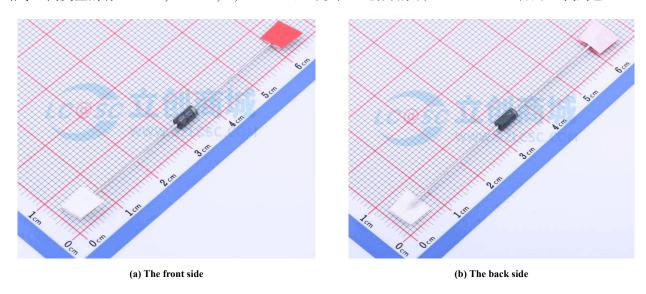


图 4.1: 1N4007 [GOODWORK (固得沃克)]

Data Sheet 中的具体参数我们不再重复了,可到数据手册中自行查找,这里给出 1N4007 在经典 NMOS 反相器电路下的实际 V-I 特性曲线。

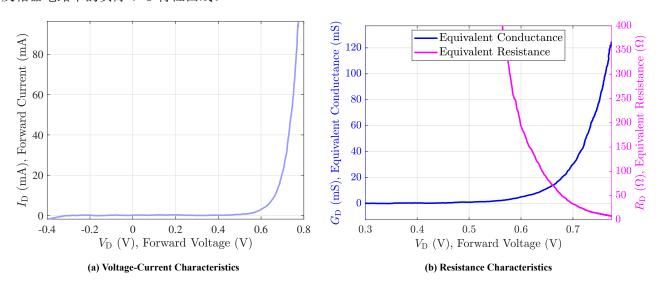


图 4.2: Characteristics of 1N4007

## §4.2 Voltage regulator diode (稳压二极管)

## §4.3 LED (Light Emitting Diode) (发光二极管)

#### 4.3.1 XL-302 [XINGLIGHT (成兴光)]

XL-302SURD (red)、XL-302SURC (white)、XL-302UYD (yellow)、XL-302UYC (green)、是由 XINGLIGHT (成兴光, 中国广东) 生产的 LED, 可以在 立创商城 或 XINGLIGHT 官网 上找到它们。其实物图如下:

#### 4.3.2 LED [某宝]

在某宝中购买大小和外观与 XL-302 相同的 LED, 其电气特性如下:

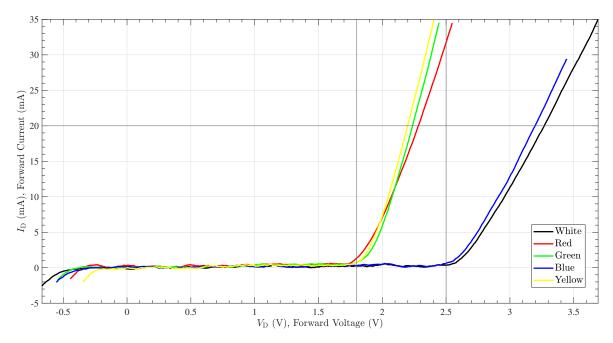


图 4.3: Voltage-Current Characteristics

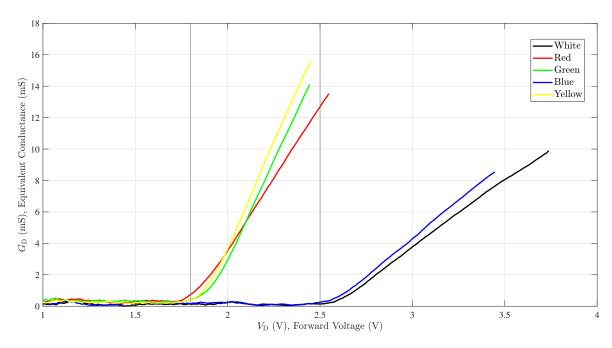


图 4.4: Equivalent Conductance Characteristics

由图可以看到,黄绿红三色导通电压  $V_{\rm th}$  和 20 mA 工作压降  $V_{\rm D}$  分别为:

$$V_{\text{th}} = 1.8 \text{ V}, \quad V_{\text{D}} = 2.3 \text{ V} \quad \text{(Yellow, Green, Red)}$$
 (4.1)

而蓝色和白色 LED 的导通电压  $V_{\rm th}$  和 20 mA 工作压降  $V_{\rm D}$  分别为:

$$V_{\text{th}} = 2.5 \text{ V}, \quad V_{\text{D}} = 3.2 \text{ V} \quad \text{(Blue, White)}$$
 (4.2)

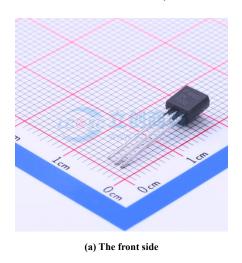
## §4.4 Schottky Diode (肖特基二极管)

## 第5章 Transistors (晶体管)

- §5.1 BTJ (Bipolar Transistor Junction) (双极型晶体管)
- §5.2 JFET (Junction Field Effect Transistor) (结型场效应晶体管)
- § 5.3 MOSFET (Metal-Oxide -Semiconductor Field Effect Transistor) (金属氧化物半导体场效应晶体管)

#### 5.3.1 2N7000 [onsemi (安森美)]

2N7000 [onsemi (安森美)] 是由 onsemi 公司生产的 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor (N-Channel Enhancement MOSFET),可以在立创商城或 GOODWORK 官网上找到它。其实物图如下:



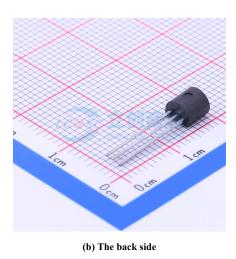


图 5.1: 2N7000 [onsemi (安森美)]

用经典反相器结构,取合适的电阻  $R_L$  用作电流表(我们这里取  $R_L = 5.2\Omega$ ),固定  $V_{GS}$ ,同时改变  $V_{DS}$ ,可以得到 MOS 的工作特性 (Operation Characteristics)  $I_{DS} = I_{DS}(V_{DS})$ ,这包括了导通特性 (On-Region Characteristics) 和体二极管特性 (Body Diode Characteristics)。

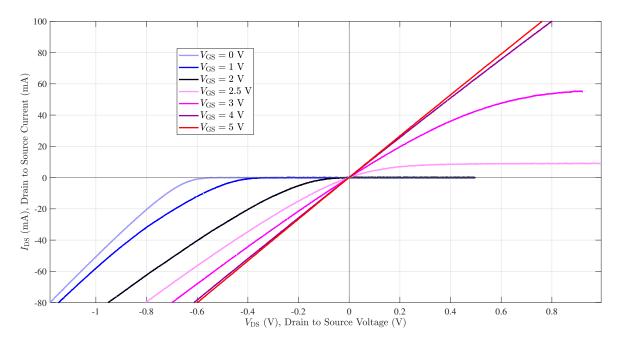


图 5.2: Operation Characteristics of 2N7000

依据实际测得的数据,可以计算出 MOS 的等效电导特性 (Equivalent Conductance Characteristics),如下图所示:

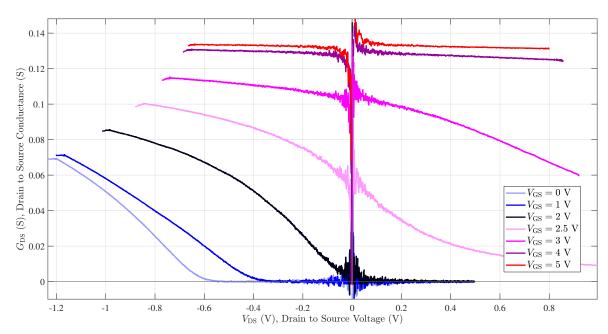


图 5.3: Equivalent Conductance Characteristics of 2N7000

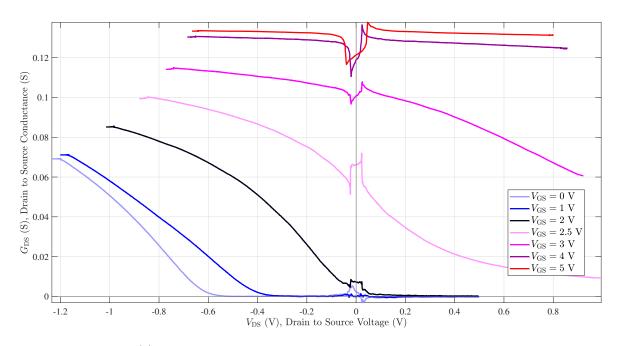


图 5.4: Filtered Equivalent Conductance Characteristics of 2N7000

固定  $V_{DS}$ , 改变  $V_{GS}$ , 串联万用表以测量  $I_{DS}$ , 得到 2N7000 的转移特性曲线  $I_{DS} = I_{DS}(V_{GS})$  如下:

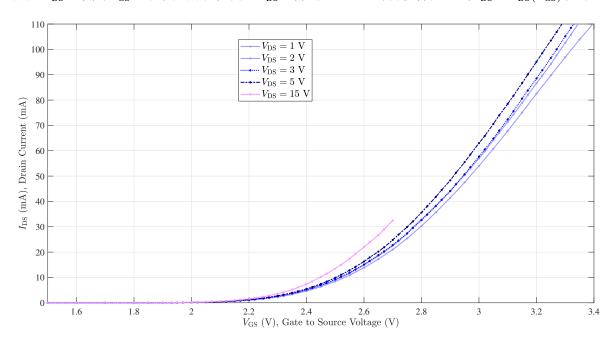


图 5.5: Transfer Characteristics of 2N7000

上图中  $V_{DS}=15$  V 时仅测到  $V_{GS}=2.7$  V,这是因为往后 MOS 管发热严重,温度不断上升,无法得到稳定示数。用  $V_{DS}=15$  V 时测得的数据拟合饱和电流公式  $I_{DS}=\frac{K}{2}\left(V_{GS}-V_{T}\right)^{2}$ ,其中 K 和  $V_{T}$  是待定参量,得到:

$$V_{\rm T} = 2.109 \,\text{V}, \quad K = 0.182 \,\text{A} \cdot \text{V}^{-2} = 182 \,\text{mA} \cdot \text{V}^{-2}$$
 (5.1)

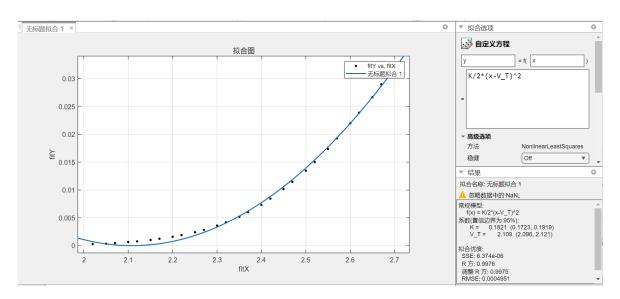


图 5.6: Threshold Voltage of 2N7000

# § 5.4 MODFET (Modulation Doped Field Effect Transistor) (调制掺杂场效应晶体管)

## §5.5 Darlington Transistors (达林顿晶体管)

# 第6章 Amplifiers

- § 6.1 Common Emitter Amplifier (共射极放大器)
- § 6.2 Common Base Amplifier (共基极放大器)
- § 6.3 Common Collector Amplifier (共集极放大器)
- § 6.4 Common Source Amplifier (共源极放大器)
- § 6.5 MOSFET Amplifier (MOSFET 放大器)
- 6.5.1 LM258P
- 6.5.2 NE5532P
- 6.5.3 LM318N
- § 6.6 Class AB Amplifier (AB 类放大器)

第7章